

第4回 Atomic Layer Process (ALP) Workshop

会議詳細

会議主旨

Atomic Layer Etching および Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition 技術の基礎を理解し、ガス・材料・プラズマ等の幅広い分野の研究者・技術者が同技術の問題意識を共有することにより、この分野の更なる技術革新を推進する事を目的とする。

日時

2019年6月21日(金) 13時 - 17時半

場所

大阪大学中之島センター 10階 佐治敬三メモリアルホール
大阪市北区中之島 4-3-53

(<http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php>)

参加費

無料

※参加ご予約の方は、事前のご登録をよろしくお願いいたします。

事前登録連絡先

唐橋一浩

(karahashi☆ppl.eng.osaka-u.ac.jp)

※メールアドレスの☆を@で置換して下さい。

プログラム

講演 30分 + 質疑 5分

13:00 - 13:10

浜口 智志 (大阪大学)

開会のご挨拶: 趣旨説明

1. 13:10 - 13:45

小口 多美夫 (大阪大学)

“マテリアルズ・インフォマティクスの概要と応用”

2. 13:45 - 14:20

生田目 俊秀 (NIMS)

“原子層堆積法による Hf 系酸化膜の作製とその特性”

3. 14:20 – 14:55

山口 欣秀 (日立)

“有機錯体の生成と熱脱離を活用した難エッチング材料の選択エッチング”

break 14:55 – 15:10

4. 15:10 – 15:45

伊藤 智子 (大阪大学)

“原子層エッチングプロセスにおける表面反応解析”

5. 15:45 – 16:20

平田 瑛子 (SONY)

“ITO 表面反応メカニズムとサイクル加工”

6. 16:20 – 16:55

熊倉 翔 (東京エレクトロン)

“イオン改質を利用した SiN, SiC エッチング (ALE)”

7. 16:55 – 17:30

堤 隆嘉, 近藤 博基, 石川 健治, 関根 誠, 堀 勝 (名古屋大学)

“プラズマ支援原子層プロセスにおける表界面反応層制御・診断”

17:30 – 17:35

浜口 智志 (大阪大学)

閉会のご挨拶

懇親会 (希望者のみ: 会費制: 要予約)

会場: 中之島センター

会費: 5,000 円

主催 大阪大学大学院工学研究科 高等プラズマ科学国際研究拠点

共催

- 日本学術振興会(JSPS) 拠点形成事業(Core-to-Core Program)
先端拠点形成型「データ駆動プラズマ科学国際共同研究拠点形成」
- 化学工学会反応工学部会 CVD 反応分科会